10;11 Моделирование рассеяния ионов аргона низких энергий на поверхностных кластерах меди

© Г.В. Корнич, Г. Бетц, В.И. Запорожченко, Н.И. Белая

Запорожский национальный технический университет, 69063, Запорожье, Украина E-mail: gkornich@zntu.edu.ua Inst. für Allgemeine Physik, Technische Universität Wien, A-1040, Wien, Austria Technische Fakultät, Christian–Albrechts–Universität, 24143 Kiel, Germany

Поступило в Редакцию 26 января 2004 г.

Выполнено молекулярно-динамическое моделирование рассеяния ионов Ar с начальной энергией 200 eV на уединенных кластерах меди, состоящих из 13 и 39 атомов и расположенных на поверхности (0 0 0 1) графита. Обсуждаются угловые распределения рассеянных ионов, их энергии и коэффициенты отражения.

В [1,2] было предложено оценивать степень покрытия поверхности графита кластерами меди согласно потоку рассеянных при бомбардировке мишени ионов Ar. Для выяснения механизмов и закономерностей рассеяния бомбардирующих ионов Ar на поверхностных кластерах меди в данной работе выполнено молекулярно-динамическое (МД) моделирование [3] взаимодействия ионов Ar, имеющих энергию 200 eV, с уединенными кластерами меди, расположенными на поверхности (0 0 0 1) графитовой подложки, в случае нормального относительно подложки начального направления движения ионов Ar. В работе использовались два кластера, состоящие из 13 (13 Cu) и 39 (39 Cu) атомов меди. Подложка состояла из двух атомных слоев, каждый из которых включал соответственно 792 и 1144 атома углерода. Методика создания двухкомпонентных систем медный кластер-подложка графита, а также используемый МД алгоритм изложены в [1]. Для обоих кластеров было выполнено по 2000 испытаний падения ионов на мишень, каждое из которых рассчитывалось в течение 0.3 рs. При создании системы

34

кластер-подложка на стадии перестройки кластера на поверхности графита в отличие от [1] свободная релаксация атомных плоскостей подложки во избежание их неконтролируемых искажений разрешалась только в направлениях вдоль (0 0 0 1) плоскостей. Часть рассеянных ионов Ar, имеющих после взаимодействия с кластером полярный угол (отсчитывается от внешней нормали к подложке) более 90° , не отражались от модельной подложки из-за ее пространственной ограниченности.

Кластеры (13 Cu) и (39 Cu) имеют принципиально различную атомную структуру. Непосредственное взаимодействие кластера (13 Cu) с поверхностью подложки осуществляется только тремя атомами Cu, что практически не изменяет его форму. В случае кластера (39 Cu) его структура изменяется при взаимодействии с подложкой в соответствии со структурой поверхности (0 0 0 1) графита [1]. В направлении, нормальном к поверхности подложки, кластер (39 Cu) состоял из 2-3 слоев атомов Cu.

Два варианта развития процесса рассеяния иона возможны в случае поверхностного кластера меди на подложке: рассеяние на кластере без значительного взаимодействия иона с подложкой и рассеяние на кластере с последующим отражением иона от подложки. В обоих случаях возможны два механизма отражения иона от кластера. Один механизм — это существенно парное взаимодействие иона с одним из атомов кластера. Другой механизм — многочастичное взаимодействие иона одновременно или последовательно с несколькими атомами кластера. В случае многочастичного механизма отражения от кластера при равных углах отражения средняя энергия отлетающего иона будет больше, чем в случае парного механизма.

Модельные вероятности распределения рассеянных ионов Ar по полярным углам (количество рассеянных ионов, попавших в каждую единицу (в приведенных расчетах — один градус) полярной угловой области / общее количество испытаний) на уединенных поверхностных кластерах меди (13 Cu) и (39 Cu) представлены на рис. 1 в виде множества точек 1 и 2, а также соответствующих кривых a и b, образованных отрезками линейных аппроксимаций по каждым последующим 10 расчетным точкам. Там же представлены угловые зависимости средних энергий (сумма энергий ионов, попавших в каждую единицу полярной области углов / количество ионов, попавших в соответствующую единицу полярной области углов) рассеянных ионов аргона



Рис. 1. Левая ось. Зависимость вероятности рассеяния Q ионов аргона на поверхностных кластерах меди (13 Cu): I, a; (39 Cu): 2, b от полярного угла θ . Правая ось. Зависимость средней энергии рассеянных ионов аргона E (eV) на поверхностных кластерах меди (39 Cu): 3, c; (13 Cu): 4, d от полярного угла θ .

(множества точек 3, 4 и кривые c, d). Видно, что значительный рост вероятности рассеяния и средних энергий отлетающих от поверхности мишени ионов приходится на углы более $35-45^{\circ}$ для обоих кластеров.

Для выяснения причины критичности значений 35–45° полярных углов отраженных ионов было выполнено моделирование взаимодействия чистой поверхности (0 0 0 1) графита с ионами Ar при полярных углах бомбардировки от 100 до 180° с шагом 5°. Получено, что с ростом полярных углов падения ионов на поверхность графита и при начальных энергиях 60, 100 и 140 eV угол падения только незначительно (~1°) отличается от угла отражения до критических полярных углов 130,



Рис. 2. Зависимость энергии E(eV) отраженного иона Ar от полярного угла падения θ_1 на поверхность графита (0 0 0 1) при начальных энергиях: I - 60 eV; 2 - 100 eV; 3 - 140 eV.

120 и 110° соответственно, а конечные энергии иона Ar при этом монотонно уменьшаются, что показано на рис. 2. При дальнейшем увеличении полярных углов падения наблюдаются резкие отклонения углов отражения от значений углов падения и значительный рост потерь энергии иона. Такой характер взаимодействия ионов с подложкой вызван локальным разрушением атомного слоя графита при полярных углах падения и прочих равных условиях наблюдается проникновение ионов в подложку. Модельный результат для чистой поверхности графита качественно согласуется с экспериментальными данными [4], где была

получена пороговая энергия 43.5 eV проникновения нормально падающих ионов Ar сквозь поверхностность (0 0 0 1) внутрь графитового слоя.

Таким образом, в области полярных углов отражения до 45° вероятность рассеяния ионов формируется главным образом за счет парных взаимодействий ион Ar-Cu атом, которые сопровождаются большими потерями энергии иона. Однако, как видно из рис. 1, такие ионы Ar составляют незначительную долю от общего числа отраженных ионов и их интенсивности рассеяния, а также средние энергии незначительно отличаются для кластеров (13 Cu) и (39 Cu). При больших полярных углах отраженных ионов, как показывает моделирование, значительный вклад составляют ионы с большими энергиями до 80 eV. Сохранение значительных кинетических энергий отраженных частиц возможно благодаря доминированию второго варианта рассеяния, а именно многочастичного взаимодействия иона с атомами кластера с результирующим полярным углом больше 90° и его последующим отражением от поверхности подложки, которое также является результатом многочастичного взаимодействия. Такой характер рассеяния проявляется в результирующем максимуме средних энергий отраженных ионов в области углов 70-90°, что видно на рис. 1. В среднем отлетающие от мишени ионы сохраняют $\sim 10{-}20\%$ начальной энергии.

Сравнение интенсивностей рассеяния ионов Ar при больших углах для кластеров (13 Cu) и (39 Cu) на рис. 1 показывает, что средняя энергия рассеянных ионов на кластере (13 Cu) существенно меньше, чем на кластере (39 Cu). Это происходит благодаря меньшей вероятности возникновения эффективных многочастичных взаимодействий, в особенности последовательных, иона Ar с атомами Cu кластера (13 Cu) по сравнению с кластером (39 Cu) в силу относительной малости первого кластера. Возрастание средней энергии рассеянных ионов при полярных углах более 90° и значительные локальные отклонения соответствующих точек вероятности рассеяния от аппроксимирующих кривых связаны с пространственной ограниченностью подложки и, как следствие, с отсутствием отражения от ее поверхности незначительной части бомбардирующих ионов после их взаимодействия с кластерами. Общие коэффициенты рассеяния ионов Ar на модельной мишени были 0.6 и 0.68 для кластеров (13 Cu) и (39 Cu) соответственно. Коэффициенты отражения ионов в области полярных углов меньше 90°

за время моделирования составили 0.56 и 0.64 для кластеров (13 Cu) и (39 Cu) соответственно. Остальные ионы Ar проникали в подложку, тогда как в кластерах меди ионы Ar не были обнаружены после 0.3 ps эволюции модельной системы.

Список литературы

- [1] Корнич Г.В., Бетц Г., Запорожченко В.И., Бажин А.И. // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29. В. 22. С. 33–38.
- [2] Корнич Г.В., Бетц Г., Запорожченко В.И., Бажин А.И. // Материалы XVI Международной конференции по взаимодействию ионов с поверхностью. Москва–Звенигород, Россия. 25–29 августа 2003. Т. 1. С. 65–68.
- [3] *Haile J.M.* Molecular Dynamics Simulation Elementary Methods. New York: Wiley–Interscience, 1992. 386 p.
- [4] Marton D., Bu H., Boyd K.J., Todorov S.S., Al-Bayati A.H., Rabalais J.W. // Surf. Sci. Lett. 1995. V. 326. C. 489–496.